

# Zweikanal-Hall-Effekt-Schalter CYD8526 mit Geschwindigkeits- und

# Richtungsausgängen

Der Schalter CYD8526 ist ein Zweikanal-Hall-Effekt-Schalter-IC, der sich ideal für den Einsatz in Geschwindigkeits- und Richtungserfassungsanwendungen mit kodierten Ringmagnet-Targets eignet. Die Hall-Elemente sind beide photolithographisch besser als 1 µm ausgerichtet. Das Aufrechterhalten einer genauen Verschiebung zwischen den beiden aktiven Hall-Elementen beseitigt die Haupthürde bei der Herstellung, die bei Anwendungen zur Feinabstimmungserkennung angetroffen wird. Der CYD8526 ist ein empfindliches, temperaturstabiles Magnetschalter, der für den Einsatz in rauen Automobil- und Industrieumgebungen geeignet ist.

Die Hall-Elemente des Sensors CYD8526 haben einen Abstand von 1,4 mm, was hervorragende Geschwindigkeits- und Richtungsinformationen für kleingeometrische Ziele liefert. Extrem driftarme Verstärker garantieren Symmetrie zwischen den Schaltern, um die Signalquadratur aufrechtzuerhalten. Ein On-Chip-Regler ermöglicht die Verwendung dieses Schalters über einen weiten Betriebsspannungsbereich von 3,5 V bis 24 V.

Der CYD8526 ist in einem 4-Pin-SIP-Gehäuse und einem Kunststoff-SOT89B-Gehäuse erhältlich. Die Gehäuse sind bleifrei (Pb) und haben eine 100 % matte Zinn-Leadframe-Beschichtung.

#### **Eigenschaften**

- Zwei aufeinander abgestimmte Hall-Schalter auf einem Substrat
- Zweikanalige Ausgänge für Geschwindigkeit und Richtung
- Gute Temperaturstabilität
- Hohe Empfindlichkeit (B<sub>OP</sub> and B<sub>RP</sub>)
- 3.5V bis 24V Versorgungsspannung
- Halbleiter -Zuverlässigkeit
- Kleine Gehäusegrößen
- RoHS-konform

## **Anwendungen**

- Einklemmschutz in Elektromotorsteuerungen
- Motor- und Ventilatorsteuerung Magnetischer Encoder
- Überwachung der rotierenden Welle
- Automotive Getriebeposition
- Garagenöffner
- Elektrische Schiebetüren
- Schiebedachmotoren

#### **Produktinformationen**

Teilnummer	Verpackung	Montage	Temperatur	B <sub>OP</sub> (typ.)	BRP (Typ.)
CYD8526VB	1000 Stück/Beutel	4-pin SIP	-40°C~150°C	+10.0mT	-10.0mT



### **Elektrische Spezifikationen**

Über den Betriebsfreilufttemperaturbereich ( $V_{DD} = 5.0 \text{ V}$ , sofern nicht anders angegeben)

Symbol	Parameter	Testbedingungen	Min.	Тур.	Max.	Einheiten
$V_{DD}$	Betriebsversorgungsspannung	$T_J < T_{J \text{ (max)}}$	3.50		24	V
I <sub>DD</sub>	Betriebsspannungsversorgung	V <sub>DD</sub> =3.5 to 24V	2.0	4.0	6.5	mA
t <sub>on</sub>	Einschaltzeit			35	50	μs
I <sub>OL</sub>	Ausgeschalteter Leckstrom	Ausgang Hi-Z			1	μA
R <sub>DS(on)</sub>	FET-Einschaltwiderstand	V <sub>DD</sub> =5V, Io=10mA, TA=25°C		20		Ω
td	Ausgangsverzögerungszeit	B=B <sub>RP</sub> to B <sub>OP</sub>		13	25	μs
tr	Anstiegszeit des Ausgangs	R1=1kΩ, Co=50pF			0.5	μs
tf	Abfallzeit des Ausgangs	R1=1kΩ, Co=50pF			0.2	μs
f <sub>BW</sub>	Bandbreite		40			kHz

## **Magnetische Spezifikationen**

Symbol	Parameter	Testbedingungen	Min.	Тур.	Max.	Einheiten
B <sub>OP</sub>	Arbeitspunkt		7.0	10.0	13.0	mT
B <sub>RP</sub>	Freigabepunkt	VB-Gehäuse	-13.0	-10.0	-7.0	mT
B <sub>HYS</sub>	Hysterese			20		mT
Во	Magnetischer Offset	Bo=(B <sub>OP</sub> +B <sub>RP</sub> )/2		0		mT

<sup>1</sup>mT = 10Gs

#### **Grenzwerte**

#### Über den Betriebsfreilufttemperaturbereich

Parameter	Symbol	Min	Max.	Einheit
Versorgungsspannung	$V_{DD}$	-0.5	35	V
Ausgangsspannung	$V_{OUT}$	-0.5	35	V
Ausgangssenkungsstrom, I <sub>OUT</sub>	I <sub>SINK</sub>	0	30	mA
Betriebstemperaturbereich	T <sub>A</sub>	-40	150	°C
Maximale Sperrschichttemperatur	T <sub>J</sub>	-55	165	°C
Lagertemperaturbereich	T <sub>STG</sub>	-65	175	°C

**Hinweis:** Spannungen, die über die hier aufgeführten Werte hinausgehen, können den Schalter dauerhaft beschädigen. Wenn der Schalter über einen längeren Zeitraum absoluten Höchstbelastungen ausgesetzt wird, kann dies die Zuverlässigkeit des Schalters beeinträchtigen.



## Thermische Eigenschaften

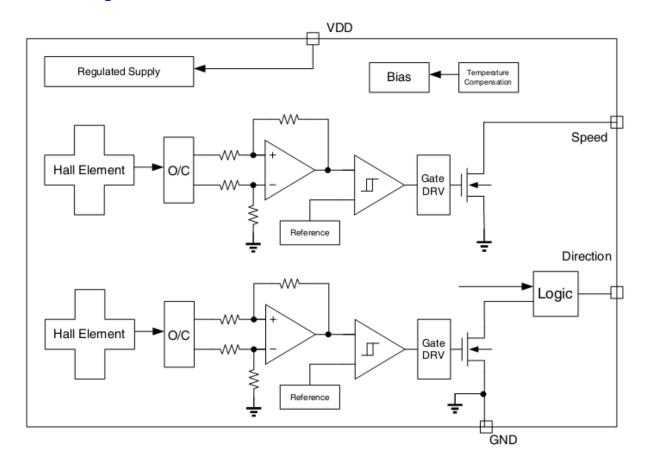
Symbol	Parameter	Testbedingungen	Wert	Einheit
$R_{QJA}$	Thermischer Widerstand des	Einlagige Leiterplatte, bei der sich das	177	°C/W
	VB-Gehäuses	Kupfer auf die Lötpunkte beschränkt		
$R_{QJA}$	Thermischer Widerstand des	Einlagige Leiterplatte, bei der sich das	140	°C/W
	BU-Gehäuses	Kupfer auf die Lötpunkte beschränkt		

#### **ESD-Schutz**

Modell des menschlichen Körpers (Human Body Model HBM) Tests gemäß: Standard EIA/JESD22-A114-B HBM

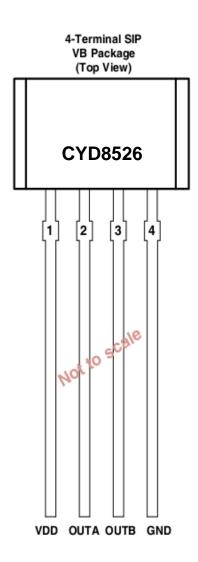
Parameter	Symbol	Min.	Max.	Einheit
ESD-Schutz	$V_{ESD}$	-6	6	KV

# **Funktionsdiagramm**





# **Terminalkonfiguration und Funktionen**

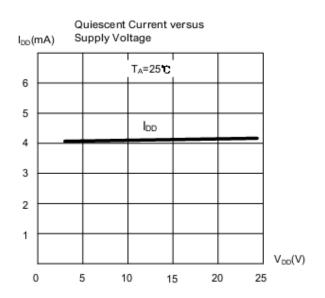


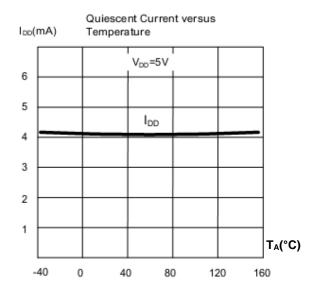
# **Pin-Anordnung**

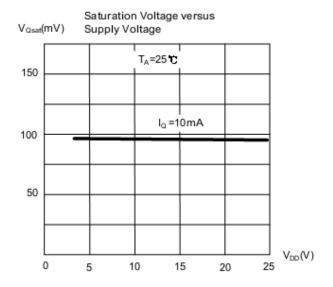
Ansc	nluss	Turn	Beschreibung	
Name	Pin (VB-Gehäuse)	Тур		
$V_{DD}$	1	Stromversorgung	3,5 bis 24 V Spannungsversorgung	
Richtungsausgang	2	Ausgang	Richtungsausgang, OC, benötigt	
			einen Pull-up-Widerstand	
Geschwindigkeits-	3	Ausgang	Drehzahlausgang, OC, benötigt einen	
Ausgang			Pull-Up-Widerstand	
GND	4	Erdung	Erdungsklemme	

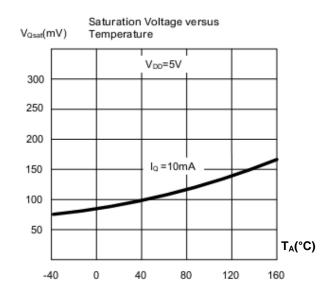


#### **Charakteristische Daten**



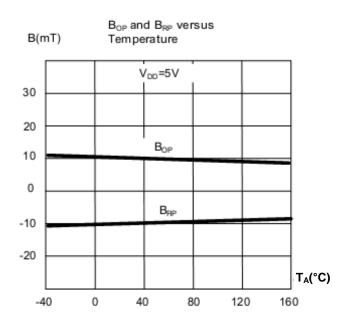


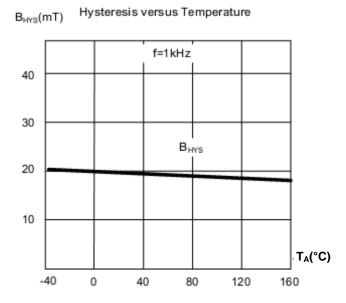




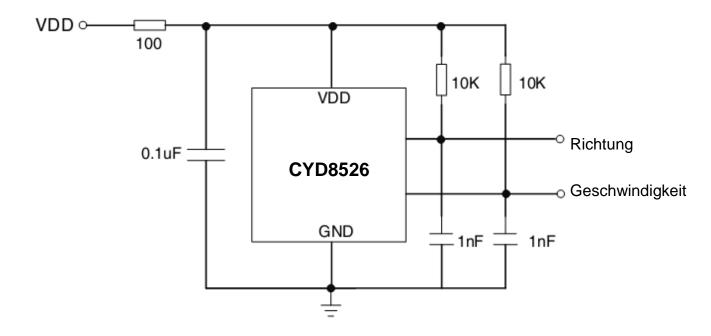


# **Charakteristische Daten (Fortsetzung)**



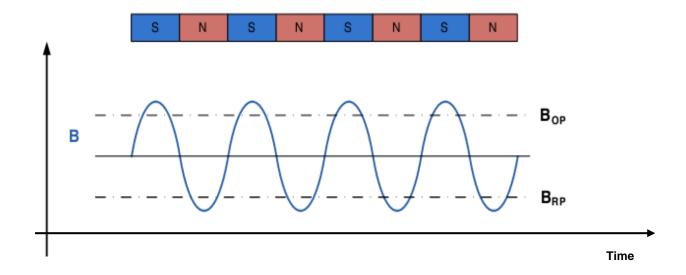


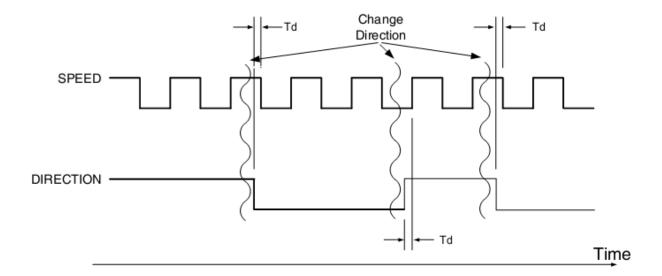
## **Typische Anwendungsschaltung**





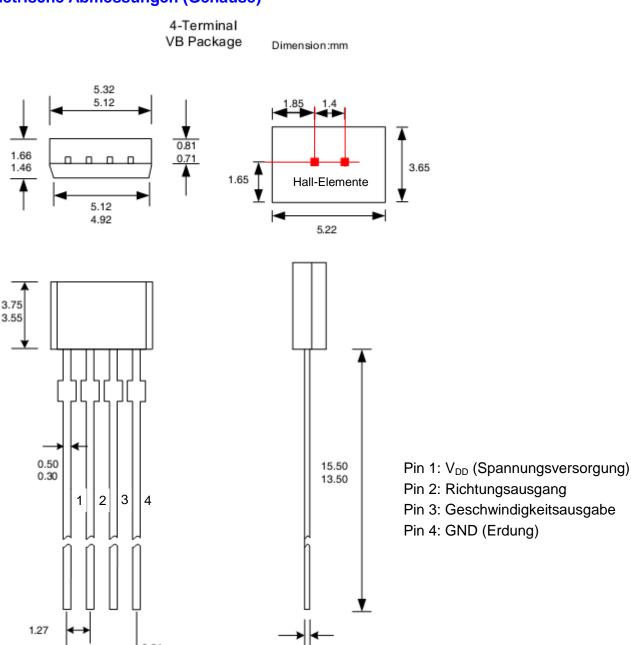
# **Typische Ausgangswellenform**







## Geometrische Abmessungen (Gehäuse)



#### Hinweise:

1. Genaue Gehäuse- und Leitungskonfiguration nach Wahl des Anbieters innerhalb der angegebenen Grenzen

0.40

- 2. Höhe beinhaltet keinen Formangussgrat
- 3. Wo keine Toleranz angegeben ist, ist das Maß nominal

3.71